

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

1 / 6

FIG. 1

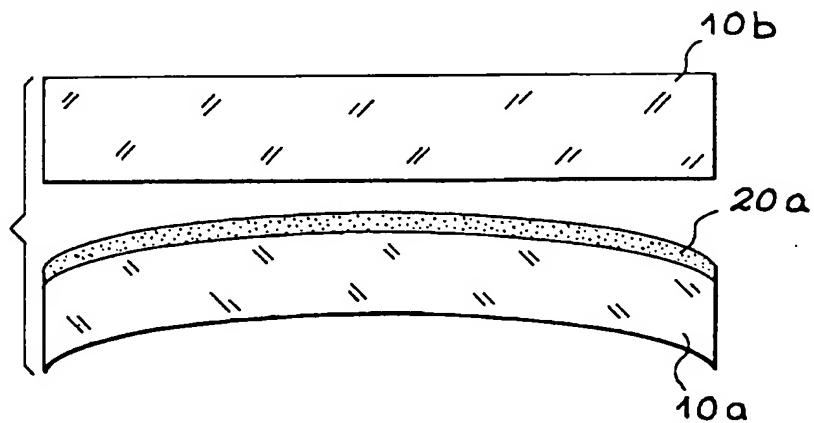


FIG. 2

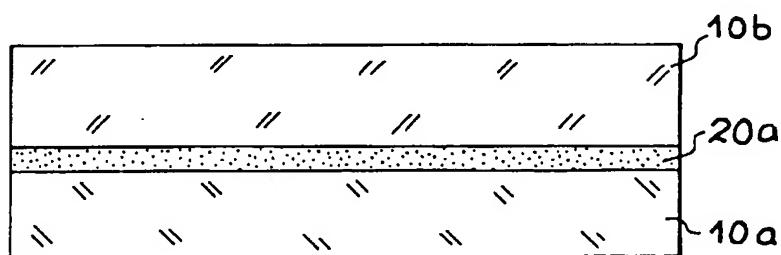


FIG. 3

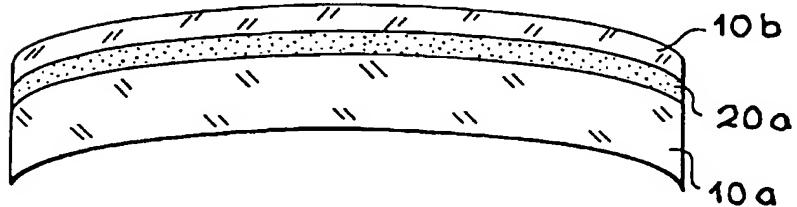
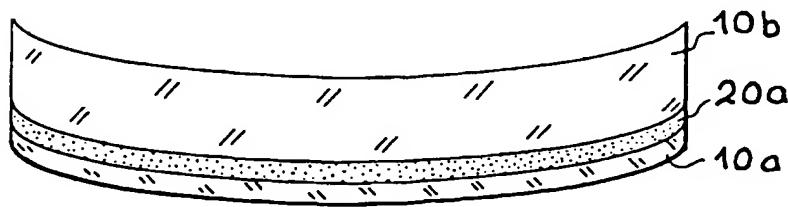


FIG. 4



216

FIG. 5

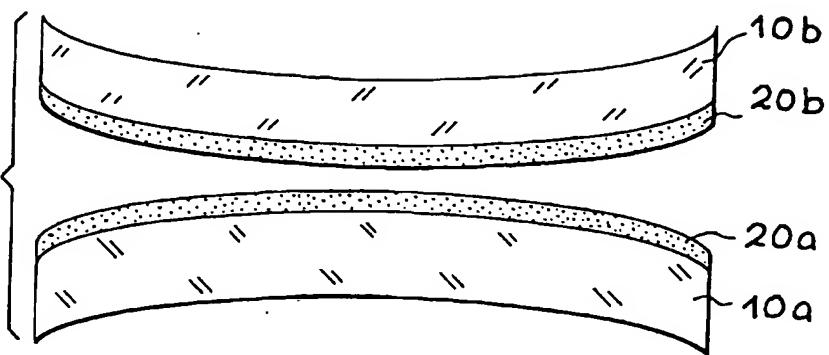


FIG. 6

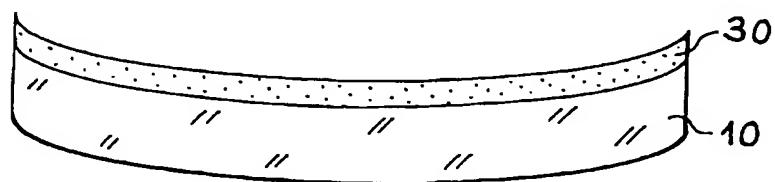
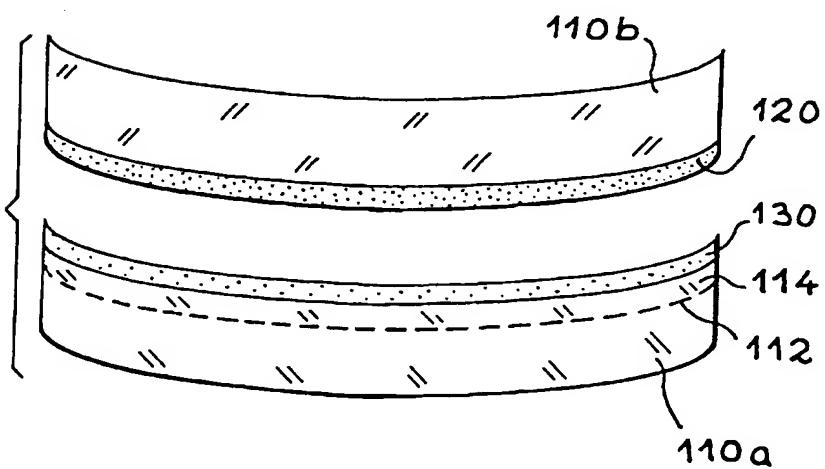


FIG. 7



3 / 6

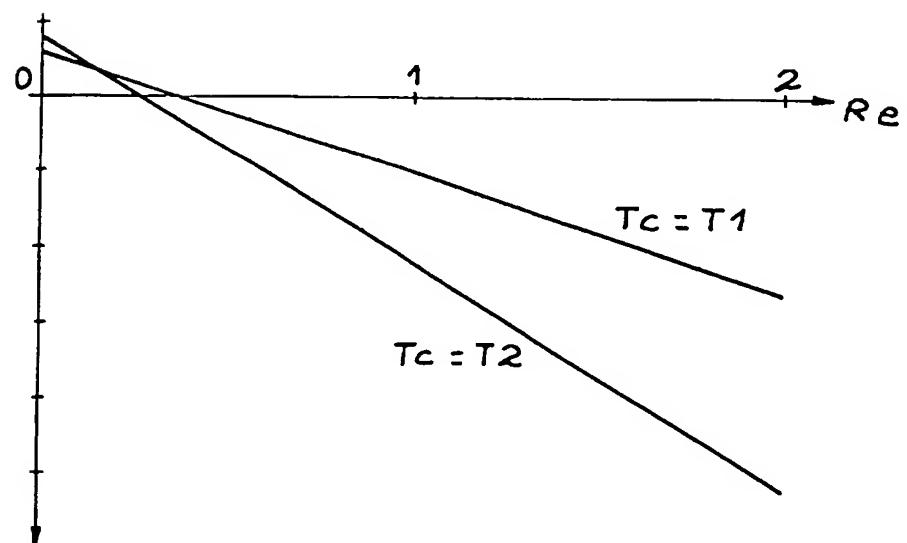
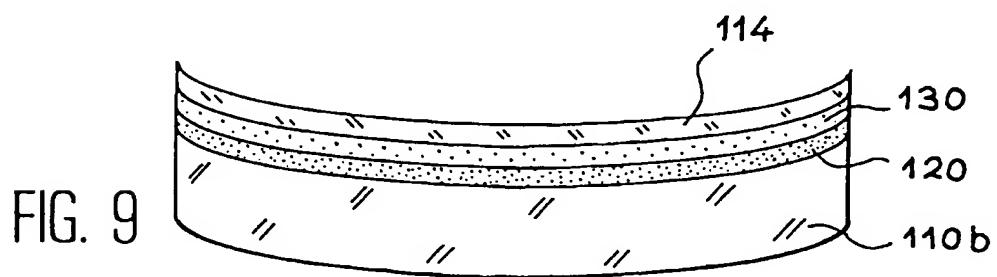
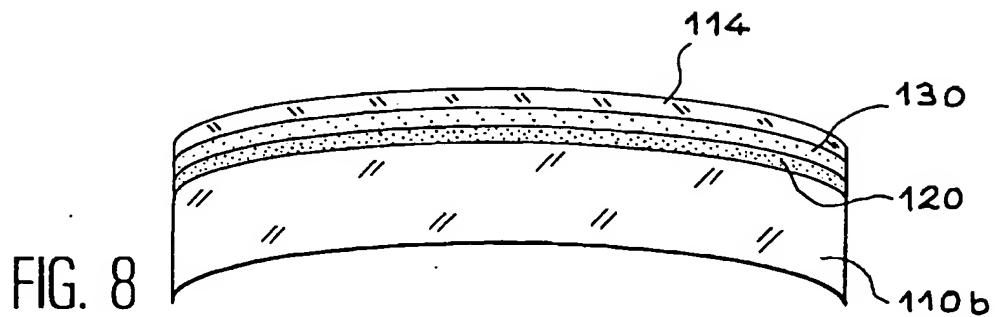


FIG. 10

4 / 6

FIG. 11

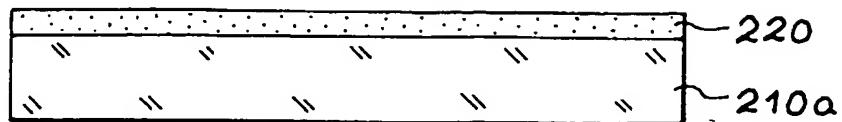


FIG. 12

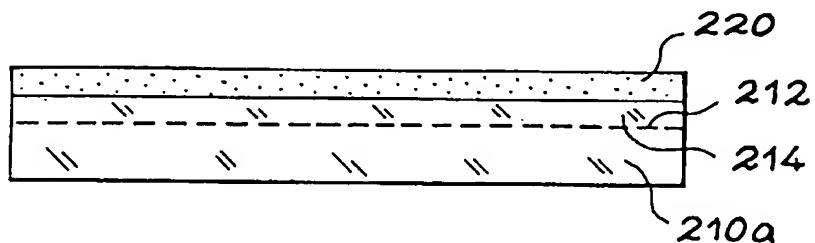


FIG. 13

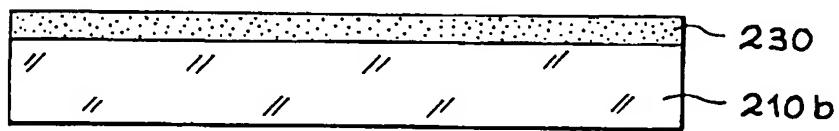


FIG. 14

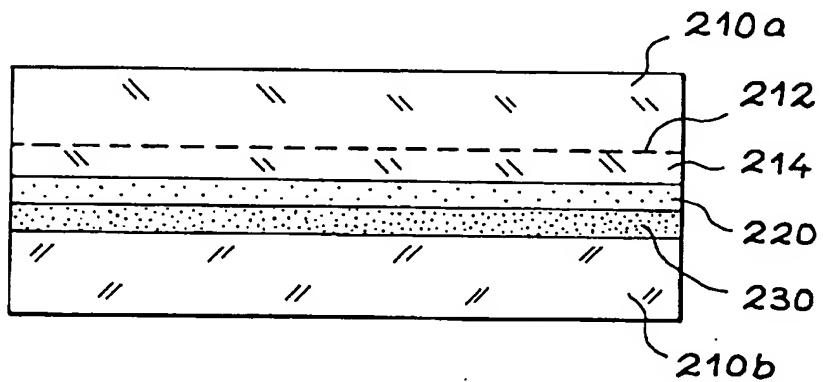
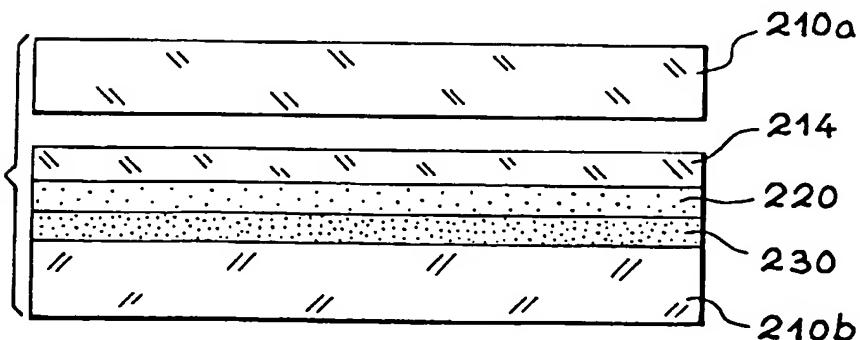


FIG. 15



516

FIG. 16

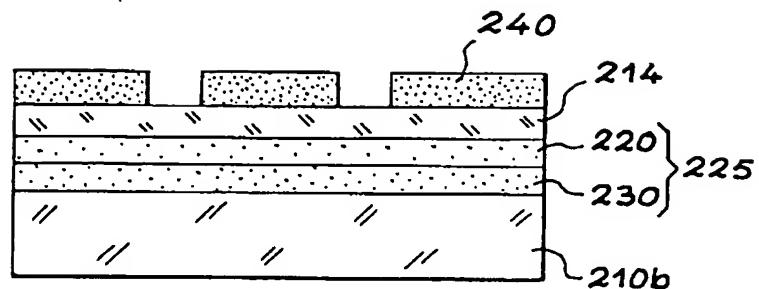


FIG. 17

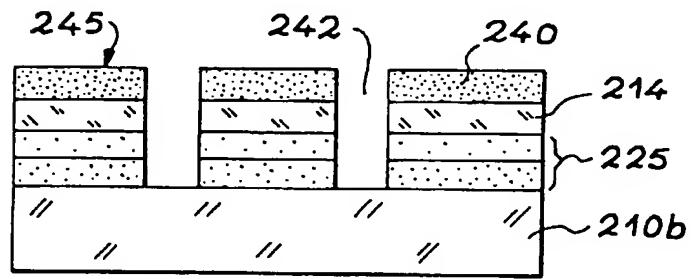
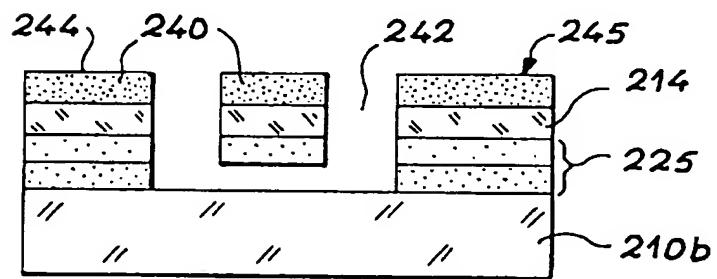


FIG. 18



616

FIG. 19

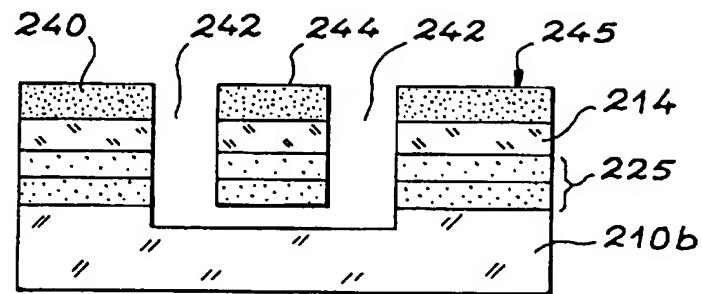
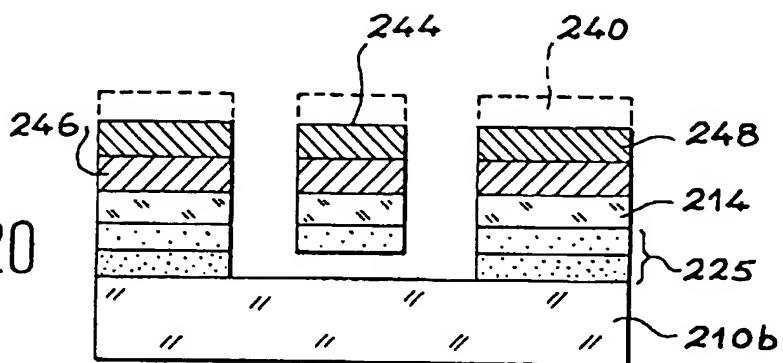


FIG. 20



INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 571693
FR 9901558

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 213 (E-1538), 15 avril 1994 (1994-04-15) -& JP 06 013593 A (NEC CORP), 21 janvier 1994 (1994-01-21) * abrégé *	1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17
X	US 5 373 184 A (TEXAS INSTRUMENTS) 13 décembre 1994 (1994-12-13) * colonne 3, ligne 15-46 *	1, 7, 8, 10
A	US 5 362 667 A (HARRIS) 8 novembre 1994 (1994-11-08) * abrégé *	4-6
A	US 5 728 623 A (NEC CORP) 17 mars 1998 (1998-03-17) * figures *	1-11, 13-16
A	EP 0 520 216 A (IBM) 30 décembre 1992 (1992-12-30) * colonne 5, ligne 38 - ligne 41 *	15
A	US 5 753 134 A (SIEMENS) 19 mai 1998 (1998-05-19) * figures 3, 6 *	19, 20
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
		H01L
2		
Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
27 octobre 1999		Gori, P
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		
T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁷ : H01L 21/20, 21/18, 21/762, B81B 3/00		A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/48238
			(43) Date de publication internationale: 17 août 2000 (17.08.00)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR00/00308 (22) Date de dépôt international: 9 février 2000 (09.02.00)		(81) Etats désignés: JP, KR, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(30) Données relatives à la priorité: 99/01558 10 février 1999 (10.02.99) FR		Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>	
(71) Déposant (<i>pour tous les Etats désignés sauf KR US</i>): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de La Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).			
(71) Déposant (<i>KR seulement</i>): SOITEC [FR/FR]; Parc Technologique Des Fontaines, F-38190 Bernin (FR).			
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (<i>US seulement</i>): MORICEAU, Hubert [FR/FR]; 26 Rue Du Fournet, F-38120 Saint-Egrève (FR). RAYSSAC, Olivier [FR/FR]; 10 Rue Du Vercors, F-38000 Grenoble (FR). CARTIER, Anne-Marie [FR/FR]; 9 Route De Girardiére, Le Genevrey, F-38450 Vif (FR). ASPAR, Bernard [FR/FR]; 110 Lot. Le Hameau Des Ayes, F-38140 Rives (FR).			
(74) Mandataire: DES TERMES, Monique; Brevatome, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).			
<p>(54) Title: MULTILAYER STRUCTURE WITH CONTROLLED INTERNAL STRESSES AND METHOD FOR MAKING SAME</p> <p>(54) Titre: STRUCTURE MULTICOUCHE A CONTRAINTES INTERNES CONTROLEES ET PROCEDE DE REALISATION D'UNE TELLE STRUCTURE</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention concerns a multilayer structure with controlled internal stresses comprising successively: a first main layer (110a), at least a first stress-adapting layer (130) in contact with the first main layer, at least a second stress-adapting layer (120) placed in contact by adherence with said first stress-adapting layer and a second main layer (110b) in contact with the second stress-adapting layer, the first and second stress-adapting layers having contact stresses with the first and second main layers. The invention is useful for electronic circuits and diaphragm devices.</p> <p>(57) Abrégé</p> <p>Structure multicouche à contraintes internes contrôlées comprenant, dans l'ordre, une première couche principale (110a), au moins une première couche d'adaptation de contraintes (130) en contact avec la première couche principale, au moins une deuxième couche d'adaptation de contraintes (120) mise en contact par adhésion avec ladite première couche d'adaptation de contraintes et une deuxième couche principale (110b) en contact avec la deuxième couche d'adaptation de contraintes, les première et deuxième couches d'adaptation de contraintes présentant des contraintes de contact avec les première et deuxième couches principales. Application à la réalisation de circuits électroniques et de dispositifs à membrane.</p>			

